



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-330982

(43) 公開日 平成9年(1997)12月22日



(51) Int.Cl.⁸

識別記号

庁内整理番号

PI

技術表示箇所

H01L 21/788

21/316

H01L 21/90

21/316

S

G

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平9-58062

(22) 出願日 平成9年(1997)3月12日

(31) 優先権主張番号 96P9578

(32) 優先日 1996年3月30日

(33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 390019839

三星電子株式会社

大韓民国京畿道水原市八達区梅灘洞416

(72) 発明者 崔 志 鉉

大韓民国ソウル特別市永登浦區大林3洞

762番地 宇成アパート5棟106號

(72) 発明者 李 海 程

大韓民国京畿道水原市八達區梅灘洞810番

地 三星2次アパート3棟206號

(72) 発明者 黄 秉 權

大韓民国京畿道安養市東安區虎溪2洞916

-2番地 コハンアパート1棟102號

(74) 代理人 弁理士 八田 幹雄 (外1名)

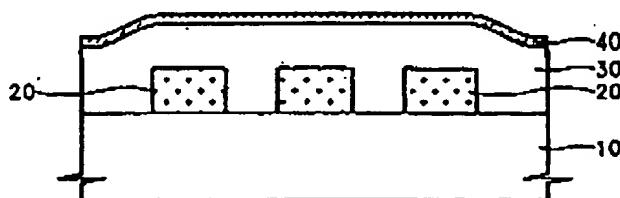
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体装置の層間絶縁膜形成方法

(57) 【要約】

【課題】 半導体装置の層間絶縁膜形成方法を提供する。

【解決手段】 所定のパターンが形成された半導体基板の全面にヒドロゲンシルセスキオキサン物質を用いるSOG層を形成し、前記SOG層を400~750℃の温度でベーキング処理して、前記ベーキング処理されたSOG層の上にプラズマ励起CVD方式により吸湿防止層を形成した後、550~750℃の温度でアニーリングする。本発明によれば、吸湿防止層によりSOG層の吸湿性を顕著に減少させ得る。



RECEIVED
DEC 17 2003
TC-1700 MAIL ROOM

BEST AVAILABLE COPY